

3. 精密制御半導体基板アライメント・表面処理及び接合システム



【仕様】

ウェハボンダ SUSS CB200m:

- ・最大4インチウェハ、最小3mm×3mm 対応
- ・ウェハに対しての加圧（最大60Kn）、加熱、冷却（室温～500℃）が可能。

大気圧プラズマ活性化装置 SUSS NP12:

- ・最大4インチウェハ、最小3mm×3mm 対応
- ・大気圧プラズマ方式、N₂、O₂、アルゴン（不活性ガス）等のプロセスガスの使用が可能

アライメント装置 SUSS BA Gen3:

- ・最大4インチウェハ、最小3mm×3mm 対応
- ・アライメントは可視光反射と赤外光透過観察に対応、
- ・アライメント装置上での位置合わせ精度は±1.0 μm以下

【特徴】

ウェハボンダ SUSS CB200m:

あらゆる種類のボンドプロセスをサポートしており、陽極接合装置に切替え可能な柔軟性を備えています。

大気圧プラズマ活性化装置 SUSS NP12:

低圧プラズマを使用し、分子レベルの表面改質を行い、低温接合を可能とします。

アライメント装置 SUSS BA Gen3:

ウェハレベルのマイクロレンズ・インプリントやその積層のほか、UV-NIL、ボンド・アライメント、UV ボンディングなど、新しく登場したプロセスにも対応します。

【作製例】

